

第四届全国宽禁带半导体学术会议大会日程

11月8日, 星期一, 上午	
	开幕式
08:00 – 08:30	领导致辞
	诺贝尔物理学奖获得者 Amano 教授视频致辞
	大会报告
08:30 – 09:00	宽禁带与超宽禁带半导体电子器件若干新进展 郝跃 院士 西安电子科技大学
09:00 – 09:30	Si 基 GaN 半导体发光 江风益 院士 南昌大学
09:30 – 10:00	大功率 GaN 蓝绿激光器芯片设计、生长和制作 林科闯 总经理 三安光电股份有限公司
10:00 – 10:20	茶歇、合影
10:20 – 10:50	基于宽禁带半导体量子结构的物理效应与器件应用 张荣 教授 厦门大学
10:50 – 11:20	深紫外 LED 研发及产业化 李晋闽 研究员 中国科学院半导体研究所
11:20 – 11:50	18 kV SiC IGBT 的研制 邱宇峰 厦门大学讲座教授 国家电网全球能源互联网研究院
11:50 – 12:20	Wide Bandgap Semiconductor, R&D History and Practical Knowledge Prof. Yogi Ota TKK Innovation Laboratory
12:20 – 13:30	午餐

11月9日, 星期二, 下午	
	大会报告
13:30 – 14:00	面向新型光电信息存储应用的功能材料基元与序构 刘益春 教授 东北师范大学
14:00 – 14:30	Selective Epitaxy: A direct epitaxy approach to achieve a monolithic on-chip integration of μLEDs and HEMTs for micro-display and VLC 王涛 教授 英国谢菲尔德大学
14:30 – 15:00	氮化镓单晶材料的 HVPE 法与液相法生长研究 徐科 研究员 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
15:00 – 15:30	High performance GaN vertical trench gate MOSFETs 刘纪美 教授 香港科技大学
15:30 – 15:50	茶歇
15:50 – 16:20	GaN 基宽禁带半导体的大失配异质外延新进展 沈波 教授 北京大学
16:20 – 16:50	新型 Micro-LED 在显示与通信领域的应用 郭浩中 教授 台湾交通大学
16:50 – 17:20	碳化硅单晶衬底的研究进展及发展趋势 徐现刚 教授 山东大学
17:20 – 17:50	闭幕式
19:00 – 21:00	晚宴
11月10日, 星期三, 参观考察及返程	